

# Спектр непрямого магнетоэкситона

© Н.Е. Капуткина, Ю.Е. Лозовик\*

Московский институт стали и сплавов,  
117936 Москва, Россия

\* Институт спектроскопии Российской академии наук,  
142092 Троицк, Россия

(Получена 12 января 1998 г. Принята к печати 5 февраля 1998 г.)

Рассмотрен двумерный экситон с пространственно разделенными электронами и дырками в связанных квантовых ямах и в вертикально связанных квантовых точках в поперечном магнитном поле для широкого диапазона характерных величин задачи — расстояния между ямами или точками  $d$  и магнитного поля  $H$ . Найдены законы дисперсии  $E_{nm}(P)$  в связанных квантовых ямах при различных  $d$  и  $H$  ( $P$  — сохраняющийся в магнитном поле магнитный импульс вдоль ям). Спектры вычислены с использованием численной диагонализации гамильтониана на различных базисах — кулоновском или Ландау (выбор базиса контролируется величиной эффективного магнитного поля). Асимптотические зависимости энергий (по  $d$ ,  $H$ ,  $P$ ) определены аналитически. С ростом импульса  $P$  спектр экситона в слабых фиксированных  $H$  перестраивается от кулоновского к магнитному и представляет собой при больших  $P$  зоны, примыкающие к уровням Ландау. Рассмотрена также задача о пространственно разделенных электроне и заряженной примеси в связанных квантовых ямах.

## 1. Введение

В последнее время активно ведутся экспериментальные исследования системы не прямых экситонов (экситонов с пространственно разделенными электронами и дырками) в связанных квантовых ямах (СКЯ), а также в двойных и связанных квантовых точках, в частности, во внешнем поперечном магнитном поле (см. [1–13]).

Анализ физических свойств электронно-дырочных систем в связанных квантовых ямах [14,15], в частности, в поперечном магнитном поле [16–21], обнаруживает весьма интересные коллективные свойства и ряд различных фаз. В частности, интересной возможностью являлось бы прямое наблюдение предсказанной в [14] сверхтекучести не прямых экситонов, проявляющейся как существование незатухающих электрических токов в каждой из квантовых ям (см. также [15,21,22]), а также в интересных квазиджоуфсоновских явлениях [23–25]. Возможность наблюдения этих фаз определяется соотношением времени жизни экситона и временем установления равновесия (время жизни должно быть значительно больше времени релаксации). Для электрона и дырки, локализованных в разных квантовых ямах, перекрытие волновых функций мало, что уменьшает вероятность взаимной аннигиляции. Приложение электрического поля, перпендикулярного слоям электронов и дырок, также уменьшает скорость рекомбинации, уменьшая перекрытие волновых функций. Магнитное поле влияет на время жизни, на коэффициент диффузии [4–6] и на спектр фотолюминесценции экситонов (см. [1–13]). Наблюдаемые эффекты трактовались как сверхтекучесть не прямых экситонов.

В этой связи представляется интересным подробно рассмотреть изолированный экситон с пространственно разделенными электронами и дырками (непрямой экситон) в поперечном магнитном поле. Задача о двумерном

(2D) экситоне в сильном магнитном поле была рассмотрена в [16] для прямого экситона и в [14,15] для непрямого экситона. Но в вышеуказанных работах рассматривались в основном лишь асимптотические случаи очень сильных магнитных полей, когда кулоновское взаимодействие можно рассматривать как малое возмущение.

Далее мы рассмотрим общую задачу о пространственно разделенном 2D экситоне во внешнем поперечном магнитном поле для широкого диапазона величины магнитного поля  $H$  и межъямных расстояний  $d$ ; найдем законы дисперсии  $E_{nm}(P)$  в СКЯ при различных  $d$  и  $H$  ( $P$  — сохраняющийся в магнитном поле магнитный импульс вдоль ям). С ростом величины эффективного магнитного поля (см. далее) спектр энергий меняется от водородоподобного спектра при  $H = 0$  к эквидистантным уровням Ландау. Отметим, что эффективное магнитное поле увеличивается с ростом не только внешнего поля  $H$ , но с ростом и  $d$  и  $P$  (для  $H \neq 0$ ).

Мы также рассмотрим задачу о пространственно разделенном экситоне в вертикально связанных квантовых точках с параболическим удерживающим потенциалом.

Для расчета мы используем диагонализацию точного гамильтониана на различных базисах.

## 2. Пространственно разделенный 2D экситон в поперечном магнитном поле

Рассмотрим пространственно разделенные электрон  $e$  и дырку  $h$  на различных плоскостях во внешнем поперечном магнитном поле. Модель справедлива для малых толщин квантовых ям  $D \ll a^*$ , где  $a^* = \frac{\hbar\epsilon}{2m^*e^2}$  — радиус двумерного экситона на одной плоскости в от-

существование поля,  $\varepsilon$  — диэлектрическая проницаемость,<sup>1</sup>  $m^* = \frac{m_e^* m_h^*}{m_e^* + m_h^*}$  — приведенная масса,  $m_{e,h}^*$  — эффективные массы электрона и дырки. Исходя из аксиальной симметрии задачи используем симметричную калибровку векторного потенциала  $\mathbf{A} = \frac{H\mathbf{r}}{2}$ .

Уравнение Шредингера имеет вид

$$\left[ \frac{1}{2m_e^*} \left( -i\hbar\nabla_e + \frac{e}{c}A_e \right)^2 + \frac{1}{2m_h^*} \left( -i\hbar\nabla_h - \frac{e}{c}A_h \right)^2 - \frac{e^2}{\varepsilon((\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_h)^2 + d^2)^{1/2}} \right] \psi = E\psi, \quad (1)$$

где  $d$  — расстояние между слоями электронов и дырок (ширина барьерного слоя в связанных квантовых ямах),  $\mathbf{r}_{e,h}$  — координаты электрона и дырки вдоль квантовых ям. Роль двумерного импульса экситона в магнитном поле играет сохраняющаяся величина — магнитный импульс, оператор которого

$$\hat{P} = -i\hbar\nabla_e + \frac{e}{c}(\mathbf{A}_e - \mathbf{A}_h) - \frac{e}{c}[\mathbf{H}, \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_h] \quad (2)$$

$\hat{P}$  коммутирует с гамильтонианом (см. [16,26,27]). Закон сохранения  $P$  связан с инвариантностью системы относительно одновременной трансляции  $e$  и  $h$  и калибровочного преобразования.

Сделаем замену координат, выделив центр тяжести экситона  $\mathbf{R} = \frac{m_e}{m_e + m_h}\mathbf{r}_e + \frac{m_h}{m_e + m_h}\mathbf{r}_h$  и координату относительного движения электрона и дырки  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_h$ .

Тогда  $\hat{P} = -i\hbar\nabla_p - \frac{e}{2c}[\mathbf{H}, \mathbf{r}]$ . Собственными функциями для оператора  $\hat{P}$  являются

$$\begin{aligned} \psi_p(\mathbf{r}_e \mathbf{r}_h) &= \psi_p(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \\ &= \exp \left\{ \left( iP + \frac{e}{2c}[\mathbf{H}, \mathbf{r}] \frac{R}{\hbar} \right) \right\} \psi_p(\mathbf{r}), \end{aligned} \quad (3)$$

$$\hat{P}\psi_p = P\psi_p.$$

Вводя  $M = m_e^* + m_h^*$  и  $\gamma = \frac{m_h^* - m_e^*}{m_e^* + m_h^*}$ , запишем уравнение для относительного движения электрона и дырки в виде

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla \mathbf{r} + \frac{ie\hbar}{2m^*c} \gamma H[\mathbf{r}, \nabla \mathbf{r}] + \frac{e^2}{8m^*c^2} [\mathbf{H}, \mathbf{r}]^2 + \frac{e^2}{m^*c} [\mathbf{P}, \mathbf{H}]r - \frac{e^2}{\varepsilon(r^2 + d^2)^{1/2}} + \frac{P^2}{2M} \right\} \psi_p(\mathbf{r}) = E\psi_p. \quad (4)$$

С использованием преобразования (см. [16,27])

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{r}) &= \Phi(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}_0) \exp \left( \frac{i\gamma \mathbf{r} \mathbf{P}}{2\hbar} \right); \\ \boldsymbol{\rho}_0 &= \frac{c}{eH^2} [\mathbf{H}, \mathbf{P}]; \quad \boldsymbol{\rho} = \mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}_0 \end{aligned} \quad (5)$$

<sup>1</sup> Мы полагаем одинаковыми диэлектрические проницаемости слоев с носителями заряда ( $e$  и  $h$ ) и барьерного слоя. В действительности, для реальных полупроводниковых гетероструктур диэлектрические проницаемости используемых в них материалов близки, но не совпадают.

уравнение для относительного движения электрона и дырки принимает вид

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla \rho + \frac{ie\hbar}{2m^*c} \gamma H[\rho \nabla] + \frac{e^2}{8m^*c^2} H^2 \rho^2 - \frac{e^2}{8m^*c^2} H^2 \rho^2 - \frac{e^2}{\varepsilon((\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\rho}_0) + d^2)^{1/2}} \right\} \Phi(\boldsymbol{\rho}) = E\Phi(\boldsymbol{\rho}). \quad (6)$$

Введем следующие единицы энергии, длины, циклотронной частоты и магнитного поля

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{2m^*e^4}{\varepsilon^2\hbar^2}; & r_0 &= \frac{\hbar^2\varepsilon}{2m^*e^2}; \\ \omega_{c0} &= \frac{2m^*e^4}{\varepsilon^2\hbar^3}; & H_0 &= \frac{2(m^*)^2e^3c}{\varepsilon^2\hbar^3} \end{aligned} \quad (7)$$

(единицы измерения энергии и длины отвечают энергии связи и радиусу двумерного экситона). Проводя обезразмеривание, представим вышеприведенное уравнение в виде

$$\left[ \Delta \rho - i\gamma\omega_L \frac{\partial}{\partial \Theta} - \frac{\omega_L^2}{4} \rho^2 + \left( \left( \frac{1}{\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\rho}_0} \right)^2 + d^2 \right)^{1/2} + E \right] \Phi(\boldsymbol{\rho}) = 0, \quad (8)$$

где  $\omega_L = \frac{\omega_c}{2}$  — ларморова частота. В наших единицах магнитная длина есть  $r_H = \sqrt{\frac{1}{\omega_L}}$ .

Данное уравнение может быть решено численно разложением по подходящему базису функций, дающему быструю сходимость при заданном соотношении параметров задачи. В эффективно слабом магнитном поле при одновременно весьма малых параметрах  $H$  (или  $\omega_L$ ),  $d$ ,  $P$  (или  $\rho_0$ ), т.е. малой величине  $\omega_L(d^2 + \rho_0^2 + 1)$ , подходящим базисом будет базис водородоподобных (для  $2D$  случая — двумерных) функций. В эффективно сильном магнитном поле (при больших величинах  $H(\omega_L)$ , либо  $d$ , либо  $\rho_0$ ) подходящим базисом будет базис функций, формально совпадающих с волновыми функциями заряженной частицы в магнитном поле. Реально такой базис подходит для промежуточных магнитных полей, а особенно хорошо — для эффективно связанных. В пределе сверхсильных магнитных полей и при  $d = 0$  наши результаты совпадают с результатами работы [16].

Для слабых магнитных полей подходящим базисом будет базис функций, близких к собственным функциям уравнения

$$\left[ \Delta \rho + E_{0nm} + \frac{1}{((\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\rho}_0)^2 + d^2)^{1/2}} \right] f_{nm}(\boldsymbol{\rho}) = 0. \quad (9)$$

Сделаем замену

$$f_{nm}(\boldsymbol{\rho}) = \chi_{nm}(\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\rho}_0) = \chi_{nm}(\mathbf{r}). \quad (10)$$

Исходя из симметрии задачи положим  $\chi_{nm}(\mathbf{r}) = e^{im\Theta} \times \Phi_{nm}(r)A_{nm}$ , где

$$\frac{\partial^2 \Phi_{nm}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi_{nm}}{\partial r} + \left( E_{0nm} - \frac{m^2}{r^2} + \frac{1}{(r^2 + d^2)^{1/2}} \right) \Phi_{nm} = 0. \quad (11)$$

В случае больших межслоевых расстояний  $d \gg 1$  задача сводится к осцилляторной задаче. Собственные функции имеют тот же вид, что и магнитные функции:

$$\Phi_{nm}(r) = A_{nm} L_n^{|m|} \left( \frac{\omega_d}{2} r^2 \right) e^{-\frac{\omega_d}{2} r^2} r^{|m|};$$

$$A_{nm} = \left( \frac{1}{\pi} \frac{n!}{(n + |m|)!} \left( \frac{\omega_d}{2} \right)^{\frac{|m|+1}{2}} \right)^{1/2}, \quad (12)$$

где  $\omega_d = \sqrt{\omega_L^2 + 2/d^3}$ .

Собственные энергии

$$E_{nm_0} = 2\omega_d \left( n + \frac{|m| + 1}{2} \right) - \gamma m \omega_L - 1/d. \quad (13)$$

Данный результат справедлив не только для эффективно слабых магнитных полей (когда  $\omega_L^2 \ll 1/d^3$  и  $\omega_d \sim \sqrt{1/2d^3}$ ), но и для произвольных магнитных полей (в приближении  $d \gg 1$  — см. далее).

При малых  $d$  поле дольше остается эффективно слабым. Для вычислений используется разложение по базису водородоподобных функций.

Система собственных функций

$$\Phi_{mn}(r) = C_{nm} e^{-\sqrt{|E_{0n}|}r} \left( \sqrt{|E_n|} \right)^{|m|+1/2} r^{|m|} \times \sum_{s=0}^{n-|m|} A_s \sqrt{|E_{0n}|^s} r^s, \quad (14)$$

где  $A_0 = 1$ ,  $A_s = A_{s-1} \frac{2(S+|m|-n-1)}{S(S+2|m|)}$ ,  $S > 0$ ;  $C_{nm}$  — нормировочный коэффициент.

Собственные значения энергии:

$$E_{0n} = -\frac{1}{4(S + |m| + 1/2)^2} = -\frac{1}{4(n + 1/2)^2}, \quad (15)$$

где  $n = S + |m| = 0, 1, 2, \dots$

Энергия зависит от единственного квантового числа  $n = S + |m|$ .

Рассмотрим влияние слабого магнитного поля — эффект Зеемана для  $2D$  экситона. В 1-м порядке теории возмущений по  $V_{00} = \frac{\omega_c^2}{4} (r^2 + \rho_0^2 - 2r\rho_0 \cos \Theta)$  имеем  $\langle 00|V_{00}|00 \rangle = \left( \frac{\omega_c}{2} \right)^2 2\rho_0$ . При  $\rho_0 = 0$  ( $P = 0$ ) поправка обращается в нуль.

Первая поправка к уровню с квантовыми числами  $m = 0$   $n = 0$  ( $n_1 = 1$ ) имеет минимум по  $\rho_0$ , т.е. по магнитному импульсу  $P$ , при  $\rho_0 = 0$  (минимум при  $\rho_0 = 0$  имеет место для основного состояния и для сильных

полей). В слабых магнитных полях поправка к водородоподобным уровням энергии  $\langle nm|V_{00}|nm \rangle \sim a_1 \omega_c^2 + a_2 P \omega_c$ , т.е. для малых импульсов энергии квадратичны по магнитному полю  $\omega_c$ , а для больших — линейны.

Численный диагонализацией гамильтониана на базе двумерных водородоподобных функций, отвечающих кулоновскому взаимодействию электрона и дырки, определяется с высокой точностью спектр энергии экситона в слабом магнитном поле  $H$ . Результатам расчета отвечает левая часть (рис. 1), соответствующая не очень большим  $P$ .

С ростом  $d$  при фиксированном  $H$  магнитное поле становится эффективно более сильным (по сравнению с взаимодействием  $e$  и  $h$ ) и удобнее использовать базис частиц в магнитном поле. Магнитное поле становится эффективно более сильным и при больших магнитных импульсах  $P(\rho_0)$  из-за возрастания среднего расстояния  $e$  и  $h$  вдоль слоя  $\rho_{eh} \sim P$ .

В случае эффективно сильных магнитных полей (а также, как показывают численные расчеты, и в случае промежуточных магнитных полей) подходящим оказывается базис собственных функций, определяемых уравнением

$$\left[ \Delta_\rho + E_{0nm} - i\gamma\omega_L \frac{\partial}{\partial \Theta} - \frac{\omega_L^2}{4} \rho^2 \right] f_{nm}(\rho) = 0, \quad (16)$$

где  $\omega_L$  — ларморова частота.

Система собственных функций имеет вид

$$f_{nm}(\rho) = e^{im\Theta} L_n^{|m|} \left( \frac{\omega_L}{2} \rho^2 \right) e^{-\frac{\omega_L}{2} \rho^2} \rho^{|m|} \times \left( \frac{1}{\pi} \frac{n!}{(n + |m|)!} \left( \frac{\omega_L}{2} \right)^{|m|+1} \right)^{1/2}. \quad (17)$$

Соответствующие собственные энергии есть

$$E_{0nm} = 2\omega_L \left( n + \frac{|m| - \gamma m + 1}{2} \right), \quad (18)$$

где  $n = 0, 1, 2, \dots$   $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$  (при  $\gamma = 1$  они совпадают со спектром Ландау).

Собственные функции задачи формально совпадают с волновыми функциями одной заряженной частицы в магнитном поле, а уровни энергии в отличие от задачи для одной частицы расщепляются (если  $\gamma \neq 1$ ) по квантовому числу  $m$ . Невозмущенный спектр системы  $f_{nm}$  полностью дискретен, но уровни энергии вырождены по  $\mathbf{P}$  (по  $\rho_0$ ).

При эффективно весьма сильных магнитных полях для оценки энергетического спектра (и волновых функций) можно ограничиться учетом переходов между уровнями с одинаковой симметрией. Тогда энергетические уровни

определяются из условия  $\sum_n (E_0)_{nm} - E) \delta_{nn'} + V_{nn'}^m = 0$ , где

$$V_{nn'}^m = -\frac{2}{\pi} \sqrt{\frac{n!n'!}{(n+|m|)!(n'+|m|)!}} \times \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n'} \frac{(-1)^{i+j}}{i!j!} \binom{n+|m|}{n-i} \binom{n'+|m|}{n'-j} \times \int \frac{e^{-t} t^{i+j+|m|}}{(d^2 + (\sqrt{t} \sqrt{2/\omega_L} + \rho_0)^2)^{1/2}} \times K \left( \left( \frac{4\rho_0 \sqrt{2/\omega_L} \sqrt{t}}{d^2 + (\rho_0 + \sqrt{2\omega_L} \sqrt{t})^2} \right)^{1/2} \right) dt, \quad (19)$$

где  $K(x)$  — полный эллиптический интеграл 1-го рода.

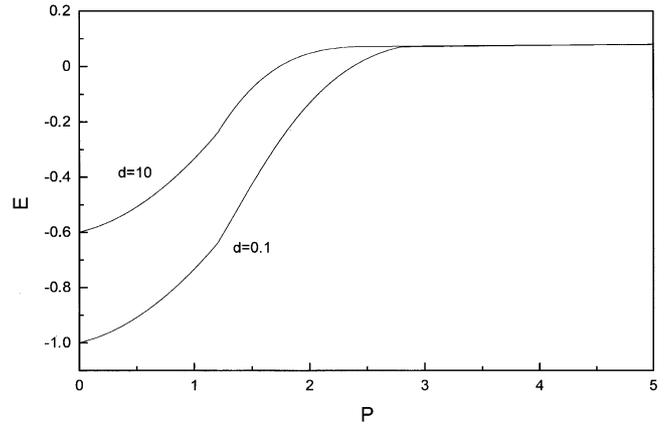
$V_{nn'}^m$  отвечает возбуждениям с переходами на уровни с одинаковой симметрией — с одинаковым квантовым числом  $m$ . Отметим, что мы не ограничиваемся первой поправкой по теории возмущений для кулоновского взаимодействия, хотя в пределе сверхсильных полей уже результаты расчета в 1-м порядке теории возмущений дают хорошую точность результатов и верные асимптотические зависимости (при  $d \rightarrow 0$ , см. результаты [16,17]). Мы же можем не пренебрегать переходами между уровнями, что распространяет область применимости используемого метода и на промежуточные магнитные поля.

В общем случае мы должны учесть переходы на уровни с разной симметрией  $m \neq m'$ , которым отвечают матричные элементы

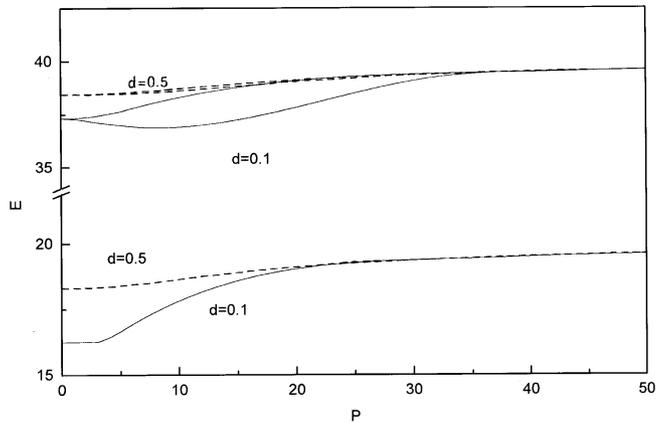
$$V_{nn'}^{mm'} = -\sqrt{\frac{n!n'!}{(n+|m|)!(n'+|m'|)!}} \frac{1}{\pi} \times \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n'} \frac{(-1)^{i+j}}{i!j!} \binom{n+|m|}{n-i} \binom{n'+|m'|}{n'-j} \times \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{e^{-t} t^{i+j+\frac{|m|+|m'|}{2}} dt e^{i(m-m')\Theta} d\Theta}{(d^2 + \rho_0^2 + (\frac{2}{\omega_L} t + 2\rho_0 (\sqrt{\frac{2}{\omega_L}}) \sqrt{t} \cos \Theta))}. \quad (20)$$

Таким образом, численной диагонализацией гамильтониана на базе соответствующих магнитных функций  $f_{nm}$  можно получить энергетические спектры пространственно разделенного экситона для широкого диапазона магнитных полей  $H$  и расстояний  $d$  между слоями  $e$  и  $h$ .

На рис. 1 показана зависимость энергии нижнего уровня от импульса  $P$  (закон дисперсии) для слабого магнитного поля  $H = 0.1$  для различных  $d$ . С ростом  $P$  энергетические уровни стремятся к уровням типа Ландау с магнитным полем (см. (18)). То же происходит и с ростом расстояния  $d$ . Итак с ростом поля  $H$ , и с ростом расстояния  $d$ , и с ростом импульса  $P$  происходит перестройка спектра от водородоподобного к магнитному.



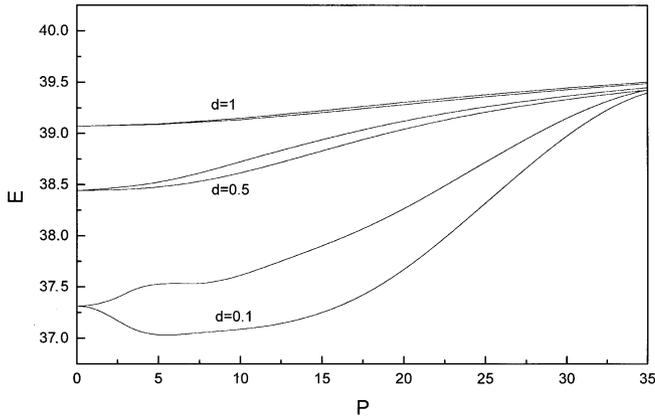
**Рис. 1.** Дисперсионные зависимости  $E(P)$  основного состояния магнетоэкситона для межслойных расстояний  $d = 0.1, 10$ ; при ларморовой частоте магнитного поля  $\omega_L = 0.1$ ,  $\gamma = 0$ .



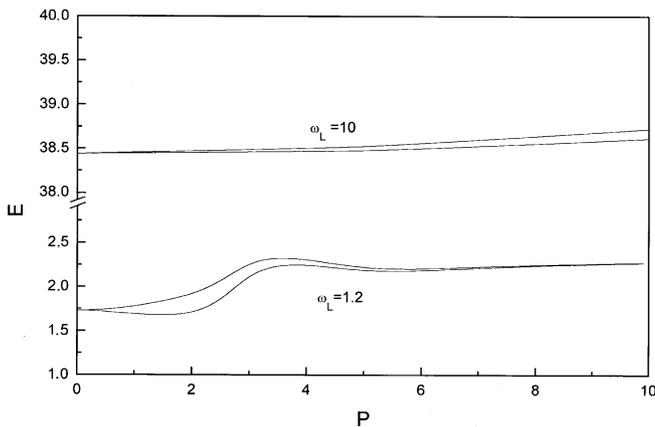
**Рис. 2.** Дисперсионные зависимости  $E(P)$  для нижних уровней энергетического спектра магнетоэкситона для межслойных расстояний  $d = 0.1, 0.5$ ; при ларморовой частоте магнитного поля  $\omega_L = 10$ ,  $\gamma = 0$ .

Законы дисперсии  $E(P)$  для нижних уровней спектра пространственно разделенного экситона в магнитном поле, полученные методом численной диагонализации гамильтониана в сильном магнитном поле  $H$  на соответствующем базисе, представлены на рис. 2. Спектр состоит из зон, примыкающих к соответствующему уровню Ландау ( $n, m$ ) и возникающих при непрерывном изменении магнитного импульса  $P$  (величины  $\rho_0$ ). С ростом  $H$  энергия растет, с ростом  $d$  — стремится к уровням Ландау. С ростом эффективного магнитного поля (с ростом  $H$  и (или)  $d$ ) указанные энергетические зоны сжимаются и все сильнее отделяются друг от друга, и спектр приближается к невозмущенному спектру  $f_{nm}$  — системе уровней Ландау (о вырожденных уровнях — см. далее).

Для основного состояния с соответствующими квантовыми числами ( $n = 0, m = 0$ ) имеется единственный экстремум (минимум) при  $\rho_0 = 0$ . Для уровней энергии,



**Рис. 3.** Дисперсионные зависимости  $E(P)$  для энергии первого вырожденного состояния магнетоэкситона для межслоевых расстояний  $d = 0.1, 0.5, 1$ ; при ларморовой частоте магнитного поля  $\omega_L = 10$ ,  $\gamma = 0$ . Видно исчезновение "ротонного" минимума с ростом  $d$ .



**Рис. 4.** Дисперсионные зависимости  $E(P)$  для энергии первого вырожденного состояния магнетоэкситона для межслоевых расстояния  $d = 0.5$ , при ларморовой частоте магнитного поля  $\omega_L = 1.2, 10$ ,  $\gamma = 0$ . Видно исчезновение "ротонного" минимума с ростом  $\omega_L$ .

отвечающих возбужденным состояниям могут существовать и другие (боковые) экстремумы, в частности минимумы. При  $d$ , отличном от нуля, с ростом эффективного магнитного поля, т. е. с ростом отношения  $d/r_H = d\sqrt{\omega_L}$ , боковые минимумы и максимумы становятся все более пологими и, наконец, исчезают. Для уровня с квантовыми числами  $n = 0$ ,  $m = 1$  выполаживание и исчезновение бокового минимума с ростом  $d$  и с ростом  $H$  (и, следовательно, с ростом  $d/r_H$ ) представлено на рис. 3 и 4.

Матричные элементы, соответствующие переходам с одинаковой симметрией, дают основной вклад для малых  $\rho_0$  и имеют экстремум при  $\rho_0 = 0$  ( $P = 0$ ). Поэтому дисперсионные кривые имеют экстремум при  $\rho_0 = 0$  ( $P = 0$ ).

В случае больших импульсов  $P \gg 1$  ( $\rho_0 \gg 1$ ) поправка к энергии

$$E_{nm}^{(1)} = V_{nm}^{nm}(P, d) = -\sqrt{\omega_L} \left[ \frac{\sqrt{\omega_L}}{P} + \frac{(\langle \rho^2 \rangle_{nm} - 2d^2) \omega_L}{4} \left( \frac{\omega_L}{P} \right)^3 \right],$$

где характерный размер волновой функции заряженной частицы в магнитном поле  $\langle \rho^2 \rangle_{nm} \sim r_H^2 = \frac{1}{\omega_L}$  для небольших  $n$  и  $m$ .

В сильных магнитных полях основной вклад в собственные значения энергий дают уровни с одинаковой симметрией, поскольку  $V_{nm'}^{mm'} \ll V_{nm'}^{mm}$   $m \neq m'$ . Соответствующие матричные элементы

$$V_{nm'}^m \rightarrow -\frac{\delta_{nm'}}{\sqrt{\rho_0^2 + d^2}} \text{ при } \rho_0 \neq 0 \text{ или } d \neq 0.$$

Роль малого параметра здесь играет магнитная длина  $\frac{1}{\sqrt{\omega_L}} = r_H$ .

Для основного состояния  $n = 0$ ,  $m = 0$ , если  $\rho_0$  или межслоевое расстояние  $d$  существенно превышает магнитную длину  $r_H$ , то поправка к энергии уровня Ландау  $E_{00}^1 \approx V_{00}^{00} \approx -\frac{1}{\sqrt{\rho_0^2 + d^2}} \left( 1 - \frac{1}{\rho_0^2 + d^2} r_H^2 \right)$ . Если же оба  $d$  и  $\rho_0 \ll r_H$ , то поправка к энергии  $E_{00}^1 \approx V_{00}^{00} \approx -\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{r_H}$ . В случае  $\rho_0 = 0$ ,  $d = 0$ , энергия  $E_{00} = E_{000} + V_{00}^{00} = \omega_L - \sqrt{\pi/2} \sqrt{\omega_L}$ .

Хотя абсолютное значение поправки растет с ростом поля как  $\sqrt{\omega_L} \left( \frac{1}{r_H} \right)$ , не его относительная величина  $\frac{|V_{00}^{00}|}{E_{000}}$  падает как  $\frac{1}{\sqrt{\omega_L}} (r_H)$ .

Для  $d \neq 0$  и  $\rho_0 \neq 0$ , начиная с некоторых значений для ларморовой частоты магнитного поля  $\omega_L$ , таких, что  $r_H \ll \max(d, \rho_0)$ , матричный элемент  $V_{00}^{00} \approx -\frac{1}{\sqrt{\rho_0^2 + d^2}} \left( 1 - \frac{1}{\rho_0^2 + d^2} r_H^2 \right)$ . Поправка растет с ростом магнитного поля, но ее относительная величина  $\frac{V_{00}^{00}}{E_{000}} = \frac{1}{\sqrt{\rho_0^2 + d^2}} r_H^2 \left( 1 - \frac{1}{\rho_0^2 + d^2} \right)$  падает как  $r_H^2$  (как  $\frac{1}{\omega_L}$ ).

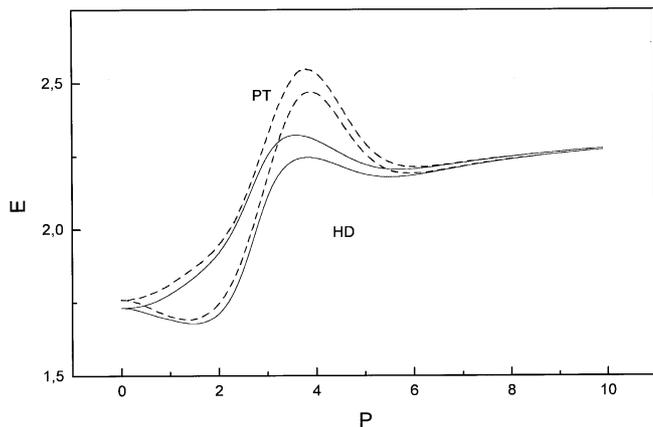
С ростом  $H$ , так же как и с ростом  $P$  или  $d$ , падает относительный вклад кулоновского взаимодействия и, соответственно, уровни становятся все ближе к уровням Ландау.

При малых же значениях "магнитных" членов в  $\hat{H}$  по сравнению с кулоновским взаимодействием картина близка к кулоновской задаче — спектр похож на спектр двумерного атома водорода.

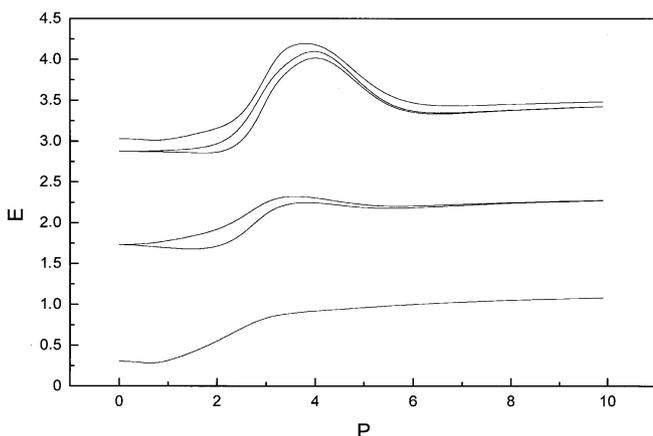
При  $\gamma = 0$ , т. е.  $m_e = m_h$ ,

$$E_{0nm} = \frac{\omega_c}{2} (2n + |m| + 1) = \omega_L \cdot k,$$

где  $k = 2n + |m| + 1$   $k = 1, 2, \dots$ . Энергия  $E_{0nm}$  зависит только от квантового числа  $k$  и  $k$ -й невозмущенный уровень  $k$ -кратно вырожден. Кулоновское взаимодействие снимает это вырождение при ненулевом импульсе  $P \neq 0$  ( $\rho_0 \neq 0$ ). В результате появляются законы дисперсии  $E(P)$ .



**Рис. 5.** Сравнение дисперсионных зависимостей  $E(P)$  для энергии первого вырожденного состояния магнетоэкситона для межслоевого расстояния  $d = 0.5$ , при ларморовой частоте магнитного поля  $\omega_L = 1.2$ ,  $\gamma = 0$ , полученных по теории возмущений по кулоновскому взаимодействию (кривые PT) и численной диагонализации гамильтониана (кривые HD)



**Рис. 6.** Дисперсионные зависимости  $E(P)$  для нижних энергетических уровней магнетоэкситона для межслоевого расстояния  $d = 0.5$ , при ларморовой частоте магнитного поля  $\omega_L = 1.2$ ,  $\gamma = 0$ .

Основной уровень  $n = 0$ ,  $|m| = 0$  ( $k = 1$ ) невырожден, а более высокие уровни вырождены. Законы дисперсии при  $\rho_0 \neq 0$  с учетом волнового взаимодействия приведены на рис. 5 и 6. Уровень невозмущенной (в пренебрежении кулоновским взаимодействием) задачи с  $k = 2$  ( $n = 0$ ,  $|m| = 1$ ) двукратно вырожден по квантовому числу  $m$  ( $m = \pm 1$ ). Для случая сверхсильных магнитных полей оценить расщепление можно, решая секулярное уравнение. Находим  $E_{k=2} = E_{0_{k=2}} \pm E_{1_{k=2}}$ , где  $E_{0_{k=2}} = 2\omega_L + V_{01}^{01}(\rho_0, d)$ ;  $E_{1_{k=2}} = -\frac{1}{(1/2)_2} \int_0^\infty e^{-t} t \frac{1}{\sqrt{b}} \left( \left( \frac{a}{b} \right)^2 - 1 \right)^{1/4} P_{-1/2}^2 \left( \frac{a/b}{\sqrt{a/b-1}} \right) dt$ , где  $P_{-1/2}^2(x)$  — присоединенная функция Лежандра.

С ростом эффективного магнитного поля расщепление уменьшается. При  $P \rightarrow \infty$  ( $\rho_0 \rightarrow \infty$ ) или  $d \rightarrow \infty$

расщепление  $E_{1_{k=2}} \rightarrow 0$ . При  $\rho_0 \ll 1$  имеем

$$E_{1_{k=2}} \approx -\sqrt{\frac{\pi}{2}} \omega_L \cdot \frac{\omega_L}{16} \left[ (3 + 6d^2\omega_L + d^4\omega_L^2) e^{\frac{d^2\omega_L}{2}} \times \operatorname{erfc} \left( d\sqrt{\frac{\omega_L}{2}} \right) - \frac{2}{\sqrt{\pi}} (5 + d^2\omega_L) d\sqrt{\frac{\omega_L}{2}} \right] \rho_0^2.$$

Для более высоких уровней законы дисперсии представлены на рис. 6.

Рассмотрим случай бесконечно тяжелой дырки  $\gamma = 1$  ( $m_h \gg m_e$ ). При  $P = 0$  имеется совпадение уровней энергии примесного состояния и экситона (для пространственно разделенного случая  $d \neq 0$ , с зарядом примеси  $+e$ ):

$$E_{0_{nm}} = 2\omega_L \left( n + \frac{|m| - \gamma m + 1}{2} \right) = \omega_c \left( n + \frac{1}{2} + \frac{|m| - m}{2} \right).$$

Уровни энергии  $E_{0_{nm}}$  бесконечно кратно вырождены. Кулоновское взаимодействие снимает вырождение  $P = 0 \rightarrow \rho_0 = 0$   $V_{nm}^{nm'} = 0$  для  $m \neq m'$ . Система уравнений расщепляется на подсистемы. Переходы между уровнями с разной симметрией не дают вклада в энергию. Для  $P = 0$  необходимо учитывать лишь взаимодействие уровней с одинаковой симметрией. Матричный элемент  $V_{00}^m = \left( \frac{\omega_L}{2} \right)^{1+|m|} d^{2|m|} \psi \left( |m|, |m| + 3/2, \frac{d^2\omega_L}{2} \right)$ . Уровень с  $n = n' = 0$  приобретает тонкую структуру из-за расщепления по  $|m|$ .

Для эффективно больших расстояний  $d$ , таких, что  $\frac{d^2\omega_L}{2} \gg 1$  ( $d \gg r_H$ ), матричный элемент  $V_{00}^m \approx -\frac{1}{d} \left[ 1 - \frac{|m|+1}{d^2\omega_L} \right]$ . Уровень с  $n = 0$  — основной уровень сдвинется вниз на величину  $\frac{1}{d}$ , и тонкая структура уровня растет вверх с ростом  $|m|$  эквидистантно ( $\approx \frac{|m|}{d^2\omega_c}$ ).

Для эффективно малых расстояний  $d$ , таких, что  $\frac{d^2\omega_L}{2} \ll 1$  ( $d \ll r_H$ ), получим  $V_{00}^m \approx -\sqrt{\frac{\omega_L}{2}} \frac{|m|-1/2}{|m|!} \left[ |m| - 1/2 - \frac{d^2\omega_L}{4} \right]$ . Тонкая структура сгущается снизу вверх к невозмущенному уровню.

С ростом квантового числа  $m$  мы можем оценить соответствующие энергетические уровни через матричные элементы  $V_{00}^m \rightarrow -\sqrt{\frac{\omega_L}{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{|m|}} - \frac{\omega_L d^2}{4|m|^{3/2}} \right) \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{|m|}}$   $|m| \rightarrow \infty$ .

Для случая примеси с зарядом  $Z \neq 1$  во все вышеприведенные формулы войдет множитель  $Z$ :  $V_{nm'}^m |_{Z \neq 1} = V_{nm'}^m |_{Z=1} \cdot Z$ .

Для рациональных  $\gamma = \frac{p}{q}$  уровни энергии без учета кулоновского взаимодействия  $E_{0_{nm}}$  и  $E_{0_{n'm'}}$  будут совпадать, если

$$\frac{2(n - n') - |m'| + |m|}{m - m'} = \gamma = \frac{p}{q},$$

$$P = 2(n - n') + |m| - |m'|, \quad q = m - m'.$$

Такие квазивырождения являются случайными совпадениями значений уровней, не отражающими внутреннюю

симметрию задачи. Поскольку наш метод допускает учет смешивания уровней с различными квантовыми числами, такие квазивырождения не ограничивают его применения (в отличие от построения 1-го порядка теории возмущений по кулоновскому взаимодействию как, например, в [16]).

Учет толщины пленок для достаточно тонких пленок в случае сильных магнитных полей закон дисперсии несколько изменяет количественно, но не качественно, причем с ростом импульса это изменение уменьшается (см. также [26,28]).

Имеется разумное согласие результатов расчета численной диагонализацией гамильтониана на соответствующем базисе и полученных в эксперименте (см. [4–6,8,9]).

### 3. Непрямой экситон в связанных квантовых точках

Экспериментально реализуется ситуация с локализацией экситона в квантовой яме [8,29], связанное с шероховатостью поверхности раздела и рассматриваемой как "естественная" квантовая точка. Возможна также локализация экситона и в искусственной квантовой точке или в вертикально связанных квантовых точках. В этой связи мы в данной работе исследуем энергетический спектр непрямого 2D экситона в следующей модели, описывающей вышеупомянутые экспериментальные реализации: электрон  $e$  и дырка  $h$  с эффективными массами  $m_e^*$  и  $m_h^*$ , находятся в разделенных барьером шириной  $d$  двух вертикально связанных двумерных квантовых точках, описывающихся, соответственно, параболическими потенциалами  $U = \alpha_e r_e^2$  и  $U = \alpha_h r_h^2$  ( $\mathbf{r}_e, \mathbf{r}_h$  — двумерные радиус-вектора  $e$  и  $h$  вдоль плоскости квантовых точек) (мы используем единицы параметра крутизны  $\alpha_0$  удерживающего потенциала:  $\alpha_0 = \frac{E_0}{r_0^2}$ ).

Сделав замену координат, выделив движение центра тяжести  $\mathbf{R} = \mu_e \mathbf{r}_e + \mu_h \mathbf{r}_h$  и  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_h$ , преобразуем уравнение Шредингера к виду

$$\left[ \mu_e \mu_h \Delta_{\mathbf{R}} + \Delta_{\mathbf{r}} + E + \frac{i\gamma\omega_c m}{2} \frac{\partial}{\partial \theta_r} - \left( \alpha_e + \alpha_h + \frac{\omega_c^2}{4} \right) R^2 - \left( \mu_h^2 \left( \alpha_e + \frac{\omega_c^2}{4} \right) + \mu_e^2 \left( \alpha_h + \frac{\omega_c^2}{4} \right) \right) r^2 + \frac{1}{(r^2 + d^2)^{1/2}} - 2 \left( \frac{\omega_c^2}{4} (\mu_h - \mu_e) + \mu_h \alpha_e - \mu_e \alpha_h \right) \mathbf{r} \mathbf{R} \right] \psi = 0. \quad (21)$$

Для упрощения рассмотрим случай  $\frac{\omega_c^2}{4} (\mu_h - \mu_e) + \mu_h \alpha_e - \mu_e \alpha_h = 0$ . Это равенство имеет место, например, для одинаковых квантовых точек и  $\mu_e = \mu_h$ . Тогда оказывается возможным разделить движение центра тяжести экситона и относительное движение электрона и дырки.

Положим  $\psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \psi_R(\mathbf{R}) \psi_r(\mathbf{r})$ . В результате получаем систему уравнений:

$$\left( \Delta_{\mathbf{R}} + \frac{E_R}{\mu_e \mu_h} - \alpha_1 R^2 \right) \psi_R = 0, \quad (22)$$

$$\left( \Delta_{\mathbf{r}} + E_r - \alpha_2 r^2 + \frac{1}{(r^2 + d^2)^{1/2}} \right) \psi_r = 0, \quad (23)$$

$$E = E_R + E_r + \frac{i\gamma\omega_c m}{2}, \quad (24)$$

где  $\alpha_1 = \frac{\alpha_e + \alpha_h}{\mu_e \mu_h} + \frac{\omega_c^2}{4}$ ,  $\alpha_2 = \mu_h^2 \alpha_e + \mu_e^2 \alpha_h + \frac{\omega_c^2}{16}$ .

Таким образом, уравнение (22) для центра масс в рассматриваемом случае имеет вид уравнения для гармонического осциллятора. Его решения для энергии центра масс  $E_R$  и собственных функций  $\psi_R$  есть

$$E_{R_{nm}} = 4\alpha_1^{1/2} \left( n + \frac{|m| + 1}{2} \right), \quad (25)$$

$$\psi_{R_{nm}} = \left( \frac{n!}{\pi (|m| + n)!} (\alpha_r)^{|m|+1} \right)^{1/2} \times R^{|m|} e^{-\sqrt{\alpha_1} R^2 / 2} L_n^{|m|} \left( \sqrt{\alpha_1} R^2 \right) e^{im\theta}. \quad (26)$$

Уравнение для относительного движения (23) отличается от уравнения для центра масс (22) учетом межэлектронного взаимодействия. В соответствии с симметрией задачи волновая функция относительного движения может быть представлена в виде  $\psi_r(\mathbf{r}) = f_m(r) \exp(im\theta)$ , где  $m = 0, \pm 1, \dots$ ; радиальная функция  $f_m(r)$  удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \left( E_r - \alpha_2 r^2 + \frac{1}{(r^2 + d^2)^{1/2}} - \frac{m^2}{r^2} \right) f = 0. \quad (27)$$

Разложим  $f_m(r)$  по базису собственных функций задачи без кулоновского взаимодействия электронов  $f_m = \sum_n C_{nm} f_{nm}$ , где  $f_{nm} = \left( \frac{n!}{(|m| + n)!} \alpha_2^{|m|+1} \right)^{1/2} r^{|m|} \times e^{-\sqrt{\alpha_2} r^2 / 2} L_n^{|m|} (\sqrt{\alpha_2} r^2)$ . Методом численной диагонализации гамильтониана на базисе этих функций мы найдем решение уравнения (27). Собственные значения энергии определяются из уравнения

$$\det \{ V_{nm'}^m + \delta_{nm'} (\varepsilon_{nm} - E_r) \} = 0, \quad (28)$$

где

$$\varepsilon_{nm} = 4\sqrt{\alpha_2} \left( n + \frac{|m| + 1}{2} \right); \quad (29)$$

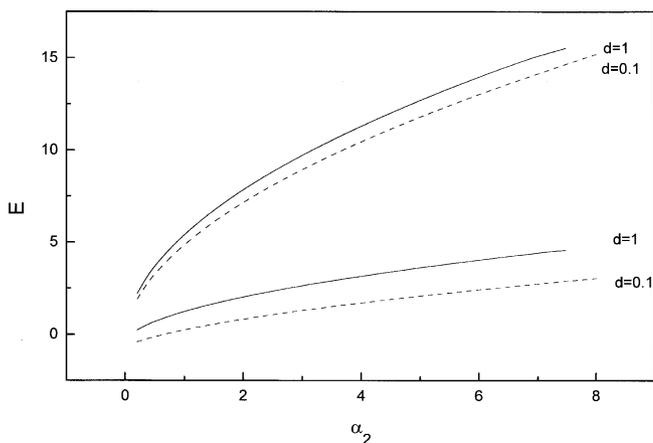
$$V_{nm'}^m = \left( \frac{n!n!}{(n + |m|)!(n' + |m|)!} \right)^{1/2} \times \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n'} \frac{(-1)^{i+j}}{i!j!} \binom{n + |m|}{n - i} \binom{n' + |m|}{n - j} \times \alpha_2^{(|m| + i + j + 1)/2} \Gamma(i + j + |m| + 1) d^{2(i + j + |m| + 1/2)} \times \Psi(i + j + |m| + 1, i + j + |m| + 3/2; \sqrt{\alpha_2} d^2). \quad (30)$$

Зависимости нижних уровней энергии  $E_r$  от параметра  $\alpha_2$  приведены на рис. 7. Значения энергетических уровней монотонно возрастают с ростом  $\alpha_2$ .

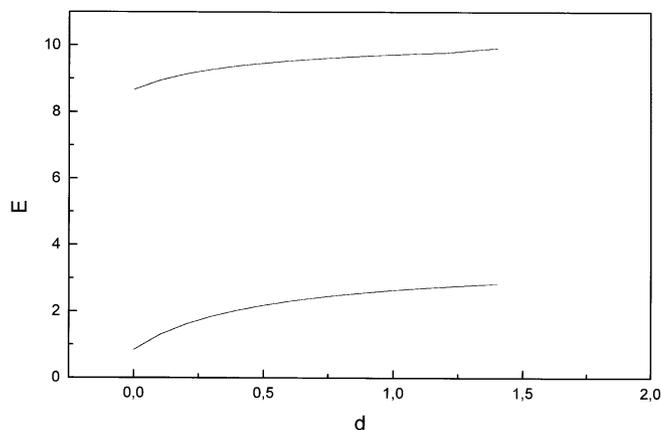
Когда  $\alpha_2$  достаточно велико (случай сильного удерживающего потенциала или большого межслоевого расстояния), межэлектронное взаимодействие мало в сравнении с другими параметрами и энергии относительного движения  $E_r$  асимптотически стремятся к уровням энергии (29) двумерного гармонического осциллятора, т.е. линейны по  $\sqrt{\alpha_2}$ . Это видно на рис. 7.

Зависимости низколежащих уровней энергии от межслоевого расстояния  $d$  приведены на рис. 8. Вклад кулоновского взаимодействия в энергию убывает с ростом  $d$ , и уровни энергии асимптотически стремятся к  $\varepsilon_{nm}$  (29).

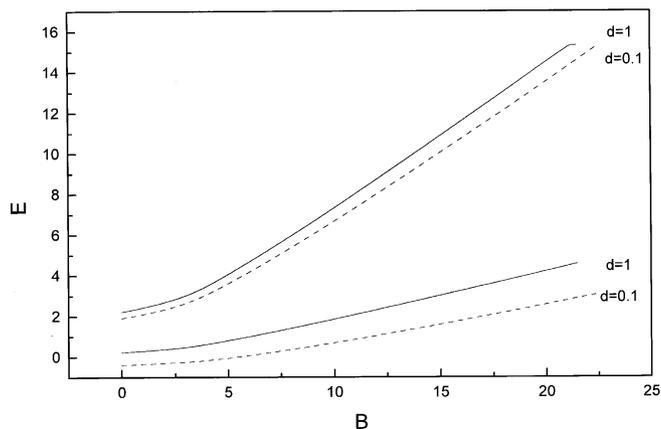
Зависимости нижних уровней энергии относительного движения от магнитного поля представлены на рис. 9. Значения энергий возрастают с ростом поля, асимптотически стремясь к  $2\sqrt{\alpha_2'}(2n + |m| + 1) + \gamma\omega_c m$ . В пределе сверхсильного магнитного поля уровни энергий асимптотически стремятся к уровням Ландау, как и



**Рис. 7.** Зависимости нижних уровней энергии  $E_r$  для пространственно разделенного экситона в связанных квантовых точках от параметра удерживающего потенциала  $\alpha_2$ .



**Рис. 8.** Зависимости низколежащих уровней энергии от межслоевого расстояния  $d$ .



**Рис. 9.** Зависимости нижних уровней энергии относительного движения пространственно разделенного экситона в связанных квантовых точках от магнитного поля  $B$  при  $\alpha_2 = 0.2$ .

в случае отсутствия параболической зависимости для удерживающего потенциала (например, модели "жестких стенок") (см. [16,17,28]).

Для больших межслоевых расстояний  $d$  имеет место асимптотическая зависимость для значений энергии:  $d \rightarrow \infty$ ,  $E \sim 2\sqrt{\alpha_2'}(2n + |m| + 1) + \gamma\omega_c m - 1/d + 1/(\sqrt{\alpha_2'})$ .

В случае малых  $d$  при  $d \rightarrow 0$  матричный элемент

$$V_{nn'}^m \rightarrow - \left( \frac{n!n'}{(n + |m|)!(n' + |m|)!} \sqrt{\alpha_2'} \right)^{1/2} \times \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n'} \frac{(-1)^{i+j}}{i!j!} \binom{n + |m|}{n - i} \binom{n' + |m|}{n' - j} \times \Gamma \left( i + j + |m| + \frac{1}{2} \right).$$

Значение  $d = 0$  отвечает случаю одной квантовой ямы с двумя носителями (см. [30]).

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, ИНТАС и программой "Физика твердотельных наноструктур".

Работа Н.Е. Капуткиной поддержана программой ISSEP для аспирантов.

## Список литературы

- [1] T. Fukuzawa, E.E. Mendez, J.M. Hong. Phys. Rev. Lett., **64**, 3066 (1990); J.A. Kash, M. Zachav, E.E. Mendez, J.M. Hong, T. Fukuzawa. Phys. Rev. Lett., **66**, 2247 (1991).
- [2] U. Sivan, P.M. Solomon, H. Strikman. Phys. Rev. Lett., **68**, 1196 (1992).
- [3] K. Brunner, G. Abstreiter, G. Böhm, G. Tränkle, G. Weiyann. Phys. Rev. Lett., **73**, 1138 (1994).
- [4] A. Zrenner, L.B. Butov, M. Hang, G. Abstreiter, G. Böhm, G. Weiyann. Phys. Rev. Lett., **72**, 3382 (1994).

- [5] L.B. Butov, A. Zrenner, G. Abstreiter, G. Böhm, G. Weiyman. Phys. Rev. Lett., **73**, 304 (1994).
- [6] L.B. Butov, A. Zrenner, G. Abstreiter, A.V. Petinova, K. Eberl. Phys. Rev. B, **52**, 12153 (1995).
- [7] S.P. Cheng, S. Kono, B.D. McCombe, I. Lo. W.C. Mitcel, G.E. Stuts. Phys. Rev. Lett., **74**, 450 (1995).
- [8] В.Д. Кулаковский, Л.В. Бугтов. УФН, **165**, 229 (1995).
- [9] M. Bayer, V.B. Timofeev, T. Gutbrod, A. Forchel, R. Steffen, S. Oshinno. Phys. Rev. B, **52**, R11 623 (1995).
- [10] M. Bayer, A. Schmidt, A. Forchel, F. Faller, T.L. Reinecke, P.A. Knipp, A.A. Dremin, V.D. Kulakovskii. Phys. Rev. Lett., **74**, 3439 (1995).
- [11] M. Bayer, V.B. Timofeev, F. Faller, T. Gutbrod, A. Forchel. Phys. Rev. B, **54**, 8799 (1996).
- [12] А.И. Филин, В.Б. Тимофеев, С.И. Губарев, Д. Биркедаль, Дж.М. Хван. Письма в ЖЭТФ, **65**, 623 (1997).
- [13] Е.С. Москаленко, А.Л. Жмодиков, В.В. Криволапчук, Д.А. Мазуренко, И.К. Полетаев, С.Т. Фоксон, Т.С. Чонг. Полупроводники-97 (М., ФИАН, 1997) с. 246.
- [14] Ю.Е. Лозовик, В.И. Юдсон. Письма в ЖЭТФ, **22**, 556 (1975).
- [15] Ю.Е. Лозовик, В.И. Юдсон. ЖЭТФ, **71**, 1167 (1976).
- [16] И.В. Лернер, Ю.Е. Лозовик. ЖЭТФ, **80**, 1488 (1981); ЖЭТФ, **82**, 1188 (1982).
- [17] И.В. Лернер, Ю.Е. Лозовик. ЖЭТФ, **78**, 1167 (1980).
- [18] D.S. Chemla, J.B. Stark, W.H. Knox. In: *Ultrafast Phenomena VIII*, ed. by J.-L. Martin et al. (Springer 1993) p. 21.
- [19] А.Б. Дзюбенко, Ю.Е. Лозовик. ФТТ, **25**, 1519 (1983); ФТТ, **26**, 51 540 (1983).
- [20] A.B. Dzuibenko, Yu.E. Lozovik. J. Phys., **24**, 415 (1991).
- [21] Ю.Е. Лозовик, О.Л. Берман, В.Г. Цветус. Письма ЖЭТФ, **66**, 332 (1997).
- [22] Ю.Е. Лозовик, О.Л. Берман. ЖЭТФ, **111**, 1879 (1997).
- [23] А.В. Ключник, Ю.Е. Лозовик. ЖЭТФ, **76**, 670 (1979).
- [24] Yu.E. Lozovik, A.V. Klyuchnik. J. Phys. C, **11**, L483 (1978).
- [25] Yu.E. Lozovik, A.V. Poushnov. Phys. Lett. A, **194**, 105 (1994).
- [26] Ю.Е. Лозовик, А.М. Рувинский. ЖЭТФ, **112**, 1791 (1997).
- [27] Л.П. Горьков, И.Е. Дзялошинский. ЖЭТФ, **53**, 717 (1967).
- [28] Yu. Lozovik, A.M. Ruvinsky. Phys. Lett. A, **227**, 271 (1997).
- [29] Г.С. Геворкян, Ю.Е. Лозовик. ФТТ, **27**, 1800 (1985).
- [30] N.E. Kaputkina, Yu.E. Lozovik. (to be published).

Редактор В.В. Чалдышев

## Spectrum of indirect magnetoexciton

N.E. Kaputkina, Yu.E. Lozovik\*

Moscow Institute of Steel and Alloys,  
117936 Moscow, Russia  
\* Institute of Spectroscopy,  
Russian Academy of Sciences,  
142092 Troitsk, Russia

E-mail: nataly@trf.misa.ac.ru

E-mail: lozovik@isan.msk.su